

Tema 4: Memoria interna. Tipos. Direccionamento. Características e funcións

Aspirante:

Avaliador:

| Apartado | Ítems de avaliación | Puntos |
|---|---|---------------|
| 1. Estrutura do tema e redacción | 1.1. Presenta índice | 0,10 |
| | 1.2. Xustifica a importancia do tema | 0,15 |
| | 1.3. Relaciona co currículo e o sistema educativo | 0,15 |
| | 1.4. Presentación organizada, estrutura coherente e pulcritude | 0,30 |
| | 1.5. Elabora a conclusión acorde co planeado. | 0,10 |
| | 1.6. Fai uso axeitado da linguaxe (normal e técnica) e boa construción sintáctica. Fluidez na redacción | 0,20 |
| Total apartado: | | 1,00 |
| 1. Memoria interna | 1.1. Introducción. Arquitectura Von Neumann | 0,2647 |
| | 1.2. Definición. | 0,2647 |
| | 1.3. Elementos Funcionais: Decodificador, Rx Información, Controlador, Transductor, Matriz | 0,2647 |
| | 1.4. Xerarquía das memorias | 0,2647 |
| | 1.4.1. Niveis: RX, Caché, Principal, Secundaria (DD, CD), Auxiliar (Cintas, Redes almacenamento) | 0,2647 |
| | 1.4.2. Características: Custe, Tempo Acceso, Capacidade | 0,2647 |
| | 1.5. Memorias Caché: L1, L2, L3. Caché de datos e instrucións | 0,2647 |
| | 2.1. Tecnoloxía dos compoñentes: biestables, condensadores e transistores MOS | 0,2647 |
| | 2.2. Volatilidade: volatil e non volatil | 0,2647 |
| | 2.2.1. Memorias RAM: SRAM e DRAM | 0,2647 |
| 2. Tipos | 2.2.2. Memorias ROM: ROM, PROM, EPROM, EEPROM e FLASH | 0,2647 |
| | 2.3. Por estrutura física (Módulos de memoria): SIMM, DIMM, RIMM – SODIMM, SORIMM, MicroDIMM | 0,2647 |
| 3. Direccionamento | 2.4. Novas tecnoloxías: LPDDR, MultiChannel, MRAM, GDDR, HBM | 0,2647 |
| | 3.1. Definición. | 0,2647 |
| | 3.2. Direccionamento 2d | 0,2647 |
| | 3.3. Direccionamento 3d | 0,2647 |
| | 3.4. Tipos. | 0,2647 |
| 4. Características e funcións | 3.4.1. Implícito | 0,2647 |
| | 3.4.2. Inmediato | 0,2647 |
| | 3.4.3. Directo | 0,2647 |
| | 3.4.4. Indirecto | 0,2647 |
| | 3.4.5. Indexado (relativo) | 0,2647 |
| 5.Outros | 4.1. Capacidade GB | 0,2647 |
| | 4.2. Volatilidade / Taxa de refresco / Durabilidade da información | 0,2647 |
| | 4.3. Modo de acceso: Lectura, Escritura | 0,2647 |
| | 4.4. Velocidade ou Tempo de Acceso | 0,2647 |
| | 4.4.1. Ancho de banda ou Taxa de Transferencia MB/s | 0,2647 |
| | 4.4.2. Frecuencia MHz | 0,2647 |
| | 4.4.3. Latencias CAS | 0,2647 |
| 4.4.4. Outras latencias: RAS, PRECHARGE, ACTIVE | 0,2647 | |
| | 4.5. Voltaxe | 0,2647 |
| | 4.6. Función de Lectura. Descrición | 0,2647 |
| | 4.7. Función de Escritura. Descrición | 0,2647 |
| | Contempla Bibliografía relacionada | 0,2647 |
| Total apartado: | | 9,0000 |
| Total rúbrica | | 10,00 |